

НИКА-SiC-6M

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА
ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ МОНОКРИСТАЛЛОВ
КАРБИДА КРЕМНИЯ

Установка «НИКА-SiC-6M» предназначена для выращивания монокристаллов карбида кремния сублимационным методом. Оборудование позволяет выращивать кристаллы диаметром до 6"



НИКА-SIC-6M

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- автоматизированная система сухой вакуумной откачки
- автоматизированная система поддержания динамического вакуума
- система вертикального перемещения индуктора
- система пирометрического измерения температуры в верхней и нижней точках теплового узла
- система вертикального перемещения нижнего пода реактора для загрузки-выгрузки теплового узла
- возможность работы в протоке рабочих газов аргон, азот или их смеси
- форвакуумный баллон для поддержания рабочего давления в реакторе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- тип нагрева индукционный
- максимальный диаметр кристалла 150 мм
- внутренний диаметр кварцевого реактора 400мм
- внутренний диаметр индуктора 420мм
- вертикальный ход индуктора 120 мм
- тип преобразователя частоты транзисторный (IGBT)
- шаг изменения мощности нагрева 0,003 кВт
- номинальная выходная частота 4-20 кГц
- предельный вакуум в реакторе $6,0 \cdot 10^{-4}$ Па
- количество линий подачи технологических газов 3 (аргон, азот, смесь газов)
- диапазон автоматического поддержания рабочего давления в реакторе 100-10(4) Па
- возможность работы в протоке газов

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, Д/Ш/В:

- модуль ростовой 1650×1420×3200 мм
- транзисторный преобразователь частоты 600×600×2200 мм
- стойка управления 800×600×1900 мм